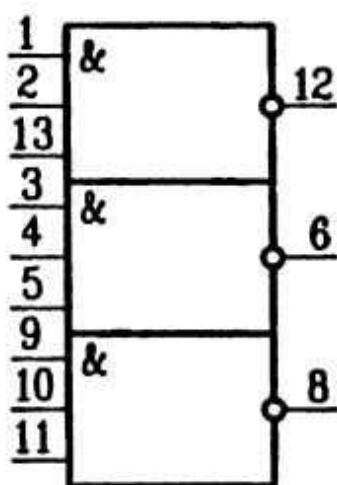


КР1533ЛА4, КФ1533ЛА4, ЭКА1533ЛА4, ЭКФ1533ЛА4

Микросхемы представляют собой три логических элемента ЗИ-НЕ.
Содержат 75 интегральных элементов. Корпус типа 201.14-1, масса не более 1 г
и 4306.14-А.

Назначение выводов: 1 - вход информационный 1D.1; 2 - вход информационный 1D.2; 3 - вход информационный 2D.1; 4 - вход информационный 2D.2; 5 - вход информационный 2D.3; 6 - выход \overline{Q} ; 7 - общий; 8 - выход $\overline{3Q}$; 9 - вход информационный 3D.1; 10 - вход информационный 3D.2; 11 - вход информационный 3D.3; 12 - выход $\overline{1Q}$; 13 - вход информационный 1D.3; 14 - напряжение питания.



Условное графическое обозначение КР1533ЛА4, КФ1533ЛА4, ЭКА1533ЛА4,
ЭКФ1533ЛА4

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания 5 В ± 10%

Прямое падение напряжения на антивонном диоде $\leq | -1,5 |$ В

Выходное напряжение низкого уровня:

- при $I_{\text{вых}}^0 = 4$ мА $\leq 0,4$ В

- при $I_{\text{вых}}^0 = 8$ мА $\leq 0,5$ В

Выходное напряжение высокого уровня $\geq 2,5$ В

Ток потребления при низком уровне выходного
напряжения при $U_{\text{п}} = 5,5$ В $\leq 2,2$ мА

Ток потребления при высоком уровне выходного
напряжения при $U_{\text{п}} = 5,5$ В $\leq 0,6$ мА

Входной ток низкого уровня $\leq | -0,1 |$ мА

Входной ток высокого уровня ≤ 20 мкА

Входной пробивной ток $\leq 0,1$ мА

Выходной ток	-10 ... -112	mA
Время задержки распространения сигнала при включении	≤ 10 нс	
Время задержки распространения сигнала при выключении	≤ 11 нс	
Емкость входа	≤ 5 пФ	

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания	4,5..5,5	V
Входное напряжение низкого уровня	0...0,8	V
Входное напряжение высокого уровня	2..5,5	V
Максимальное напряжение, подаваемое на выход	5,5	V
Температура окружающей среды	-10...+70	°C

Общие рекомендации по применению

Безотказность работы микросхем в аппаратуре достигается: правильным выбором условий эксплуатации и электрических режимов микросхем; соблюдением последовательности монтажа микросхем в аппаратуре, исключающих тепловые, электрические и механические повреждения микросхем.

Лужение производить в следующих режимах: температура расплавленного припоя не более 260 °C; время погружения не более 2 с; расстояние от корпуса до зеркала припоя (по длине вывода) не менее 1 мм; допустимое количество погружений не более 2; интервал между двумя погружениями не менее 5 мин.

Лужение и пайка должны производиться предпочтительно припоеем ПОС61 по ГОСТ 21930-76, флюсом, состоящим из 25% по массе канифоли и 75% по массе изопропилового или этилового спирта.

Установку микросхем на плату производить с зазором, который обеспечивается конструкцией выводов.

Пайку микросхем на печатную плату одножальным паяльником производить по следующему режиму: температура жала паяльника не более 270 °C; время касания каждого вывода не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между пайками соседних выводов не менее 3 с.

Жало паяльника должно быть заземлено.

Пайку микросхем на печатную плату групповым способом производить по следующему режиму: температура жала группового паяльника не более 265 °C; время воздействия этой температуры (одновременно на все выводы) не более 3 с; расстояние от корпуса до места пайки (по длине вывода) не менее 1 мм; интервал между двумя повторными пайками выводов не менее 5 мин.

Операцию очистки печатных плат с микросхемами от паяльных флюсов производить тампоном или кистью, смоченными спирто-бензиновой смесью в пропорции 1:1, ацетоном, спиртом или трихлорэтиленом, исключив при этом механическое повреждение выводов.

Сушку печатных плат с микросхемами после очистки производить при температуре не выше 60 °C.

Для влагозащиты плат с микросхемами применять лак УР-231 по ТУ 6-10-863-84 или ЭП-730 по ГОСТ 20924-81. Оптимальная толщина покрытия лаком УР231 должна быть 35...55 мкм, лаком ЭП-730 - 35...100 мкм.

Количество слоев 3.

Рекомендуемая температура сушки (полимеризации) лака 65 ± 5 °C.

Свободные входы необходимо подключать к источнику постоянного напряжения 5 В $\pm 10\%$, к источнику выходного напряжения высокого уровня или заземлять.

Допустимое значение электростатического потенциала 200 В.